

SWITCHING TRANSISTORS N-P-N

SCHALTTRANSISTOREN N-P-N

Type	Maximum ratings ● Grenzdaten						I_{CBO} at	U_{CB}	h_{21E} at	U_{CE}	I_C	f_T	t_{on}	t_{off}	Case
Typ	U_{CBO}	U_{EBO}	U_{CEO}	I_C	P_C	ϑ_j	max bei		bei				max	max	Gehäuse
	V	V	V	mA	W	°C	μA	V		V	mA	MHz	ns	ns	
KSY21	40	5	15	500	0,36 ²⁾ 1,0 ¹⁾	200	0,025	20	30—120 > 10	1 5 10	10 500 20	> 300	40	40	T11
KSY34D	60	5	40	600	2,6 ¹⁾	200	0,07	50	> 10	1 10	500 30	> 200	50	95	T24
KSY62A B	25	5	15	200	1 ¹⁾ 0,35 ²⁾	200	0,5	15	20—60 30—300	1 1 10	10 10 10	> 200	40	75	T11
KSY63	40	5	15	200	1 ¹⁾ 0,35 ²⁾	200	0,025	20	30—120	1 10	10 10	> 300	40	75	T11
KSY71	40	4,5	15	200	1,0 ¹⁾ 0,36 ²⁾	200	0,4	20	40—120 > 20	1 2 10	10 100 10	> 500	12	18	T11
KSY72	40	4,5	15	200	0,2 ²⁾ 0,7 ¹⁾	155	0,4	20	40—250	1 10	10 10	> 450	15	25	T11
TR12	12	5	10	100	0,2 ²⁾	200	0,4	10	> 25	0,3	30 10	— —	12	18	T11
TR13	12	5	12	200	0,2				> 20	0,4	80		40	40	T11
TR18	40	4,5	20	200	0,3				> 40	1	80		40	40	T11
8342—1		5	12	500	0,36 ²⁾				30—120	0,5	30	> 200			T11
8342—2		5	12	500	0,36 ²⁾				25—125	1	170	> 800	$t_s = 3 \dots 12$		T11

1) $\vartheta_a \leq 45^\circ\text{C}$, with ideal cooling ● mit idealer Kühlung2) $\vartheta_a \leq 25^\circ\text{C}$, without cooling ● ohne Kühlung

SWITCHING TRANSISTORS P-N-P

SCHALTTRANSISTOREN P-N-P

Type	Maximum ratings ● Grenzdaten						$-I_{CBO}$ at	$-U_{CB}$	h_{21E} at	$-U_{CE}$	$-I_C$	f_T	t_{on}	t_{off}	Case
Typ	$-U_{CBO}$	$-U_{EBO}$	$-U_{CEO}$	$-I_C$	P_C	ϑ_j	max bei		bei				max	max	Gehäuse
	V	V	V	mA	W	°C	μA	V		V	mA	MHz	ns	ns	
TR15	10	4	10	200	0,2 ¹⁾	200	5 ²⁾	6	> 35 > 20	0,5 0,6 2	30 4 4	> 200	60	90	T11
TR23	10	2	10		0,1 ¹⁾				> 40	1	5	> 300	60	90	T11
KSY81	12	4	12	200	1,0 ²⁾	200	0,08	6	40—150 > 30	0,5 0,3	30 10	> 400	60	90	T11
KSY82	12	4	10	100	0,2 ¹⁾	155	0,08	6	35—135 > 30	0,5 0,3	30 10	> 250	60	90	T11

1) $\vartheta_a \leq 25^\circ\text{C}$, without cooling ● ohne Kühlung2) $\vartheta_a \leq 45^\circ\text{C}$; with ideal cooling ● mit idealer Kühlung